



マイクロン、1 β テクノロジーを採用した 高速7,200MT/s DDR5メモリを提供開始

最先端の1 β 技術をサーバーやPC向けに拡張、パフォーマンスを50%向上

2023年10月10日 - アイダホ州ボイシ発 — Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU、マイクロンテクノロジー)は本日、業界をリードする1ベータ(1 β)プロセスノード・テクノロジーの適用を広げ、新たに16Gb DDR5メモリを発表しました。この1 β DDR5 DRAMは、最大7,200 MT/s(MT/秒)のシステム機能を実現し、現在、すべてのデータセンターやPCメーカーを対象に出荷が開始されています。マイクロンの1 β ベースのDDR5メモリは、先進のHigh-k CMOSデバイステクノロジー、4相クロッキング、クロックシンク^{*1}などを活用し、旧世代と比較して性能は最大50%向上^{*2}、ワットあたりの性能は33%改善^{*3}しています。

データセンターでのワークロード需要対策としてCPUコア数の増加が求められるに伴い、顧客は総所有コスト(TCO)を最適化と同時に「メモリの壁」の克服のため、メモリ帯域幅と容量を一層、向上させる必要が生じています。マイクロンの1 β DDR5 DRAMは、人工知能(AI)の学習や推論、生成AI、データ分析、インメモリデータベース(IMDB)などのアプリケーションの稼働を、データセンターやクライアント・プラットフォームを問わず高いパフォーマンスで実現します。新しい 1 β DDR5 DRAM製品ラインナップは現行製品と同じモジュール容量で用意され、データセンターやクライアント・システムを対象に4,800MT/sから7,200MT/sの速度に対応します。

マイクロンのコア・コンピュータ・デザイン・エンジニアグループ担当コーポレートバイスプレジデントのブライアン・キャラウェイは「クライアント／データセンター・プラットフォーム向け1 β DDR5 DRAMの量産と提供開始は、業界における重要な節目となります。マイクロンのエコシステム・パートナーや顧客との協業により、より高性能なメモリの迅速な導入が促進されます」と述べています。

マイクロンの1 β テクノロジーにより、16Gb／24Gb／32GbのDRAMダイを使用したDDR5 RDIMM／MCRDIMM、[16Gb／24GbのDRAMダイを使用したLPDDR5X／HBM3E／GDDR7](#)など、メモリベースソリューションの多彩なポートフォリオが提供されます。Micron 16Gb DDR5メモリは本日より、コマース／チャネル・パートナーを通じて提供されます。



業界関係者のコメント:

「コンシューマーやゲーム用の高性能ノートPCのリーダーであるASUSにとって、メモリサブシステムのDDR5への移行は重要事項です。ASUSとROGのノートブックにマイクロンの1β DDR5を搭載し、お客様が求める優れたユーザー体験性能を提供できることを嬉しく思います」

- ASUS アソシエイト・バイス・プレジデントY.C. チェン (Y.C. Chen) 氏

「Ampereのクラウドネイティブ・プロセッサとマイクロンの最先端の1β DDR5により、ハイパースケーラが必要とするパフォーマンス、拡張性、電力効率を実現するクラス最高のコンピュータソリューションを提供できます。7,200MT/sに対応するマイクロンの1β DDR5をAmpereOne™プラットフォームに早期に統合させることにより、AI、機械学習、その他あらゆるハイパフォーマンス・コンピューティング・アプリケーションの進歩が今後も促進されると期待しています」

- Ampere Computing チーフ・プロダクト・オフィサー ジェフ・ウィティッチ (Jeff Wittich) 氏

「マイクロンとの提携により、業界をリードする当社の DDR5、LPDDR5X、GDDR6、HBM3 IP システム・ソリューションと、マイクロンのワールドクラスのメモリ・ポートフォリオを活用し、ターゲットアプリケーションに最適化された次世代プラットフォームを実現できることを嬉しく思います。マイクロンの先進的な1β DDR5メモリの活用により、最大7,200MT/sの速度を備えた高性能DDR5 IPの評価と認定を行うことが可能になります」

- Cadence IP グループ担当 バイスプレジデント兼ジェネラル・マネージャー ボイド・フェルプス (Boyd Phelps) 氏

参考資料:

・ [DDR5 ウェブページ](#)

・ [DDR5 紹介動画](#)

*1: JEDECオプションのSRX/NOPクロックシンク (CLK_SYNC) 機能は、ホストからDRAMへのデューティ・サイクルの歪みの影響を緩和することを目的としています。

*2: 理論上の最大帯域幅に基づいた、コンポーネントレベルの性能向上: (7200-4800)/4800

*3: ワットあたりの性能 (理論上の最大BW、コンポーネントレベル): Y52K 7,200MT/秒 対 Y32A 4,800MT/s (7,200MT/sのGstressバス使用率(58%)を予測して計算、SPR E-stepシステムで測定)

Micron Technology, Inc.について

マイクロンは、情報活用のあり方を変革し、すべての人々の生活を豊かにするために、革新的なメモリおよびストレージソリューションを提供するリーディングカンパニーです。顧客第一主義を貫き、テクノロ



ジーの最前線でリーダーシップを発揮し続け、洗練された製造技術と事業運営を妥協なく追求するマイクロンの製品ポートフォリオは、DRAM、NAND、NORの各種メモリからストレージ製品まで多岐にわたり、Micron®またはCrucial®のブランドを冠した高性能な製品を多数展開しています。マイクロンで生まれた数々のイノベーションは、データの活用を加速すると同時に、人工知能や5Gといった最先端分野の進歩の基盤として、データセンターからインテリジェントエッジ、さらにはクライアントコンピューターとモバイルをまたいだユーザーエクスペリエンスまで、さまざまな事業機会を新たに生み出し続けています。Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU)に関する詳細は、micron.comをご覧ください(英語)。

©2023 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 情報、製品および仕様は予告なく変更される場合があります。マイクロン、マイクロンのロゴ、およびその他のすべてのマイクロンの商標はMicron Technology, Inc.に帰属します。他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。